

**性能特点：**

- 频带：0.5~18GHz
- 插入损耗：1.6dB
- 隔离度:45dB 回波损耗：18dB
- 类型：吸收式单刀双掷
- 芯片尺寸：1.5mm×1.2mm×0.1mm

**产品简介：**

HH-SW200518 是一款 GaAs 单刀双掷吸收式开关芯片，该芯片具有带内插损小、体积小、易集成等特点。其频率范围覆盖 0.5~18GHz，插入损耗≤1.6dB。

**电参数：( TA=25°C )**

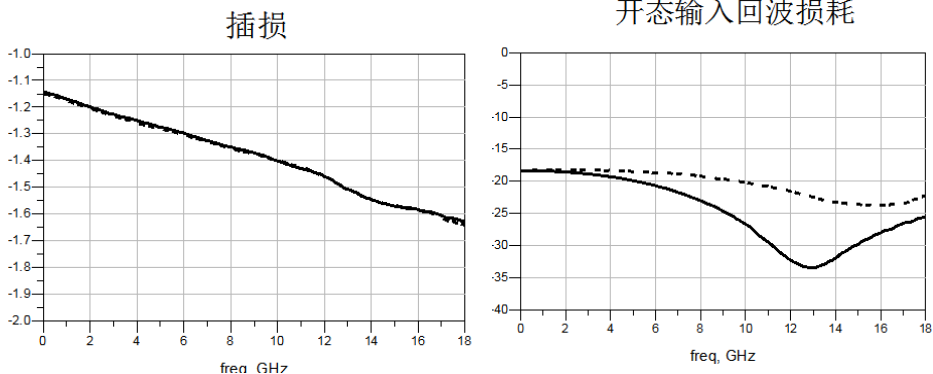
参数名称	频率 ( GHz )	Min	Typ	Max	单位
插损	0.5~18	-	1.6	1.8	dB
隔离度	-	-	45	-	dB
开态回波损耗	-	-	18	-	dB
关态回波损耗	-	-	20	-	dB

**使用限制参数：**

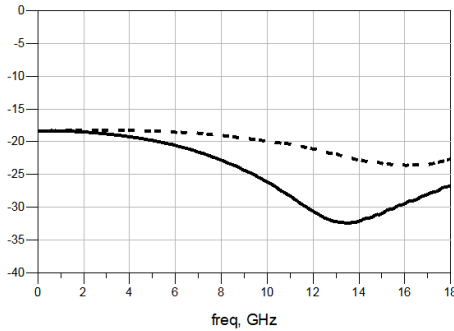
输入功率	+23dBm
存储温度	-65°C~175°C
使用温度	-55°C~85°C

**真值表：**

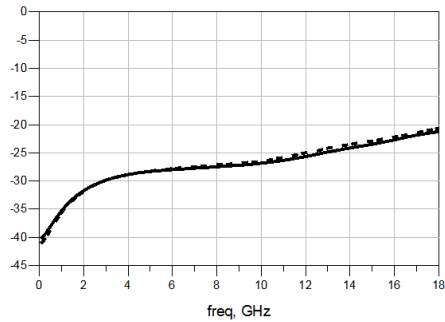
VEE ( V )	A1 ( V )	OUT1	OUT2
-5	0	On	Off
-5	+5	Off	On

**典型曲线：**


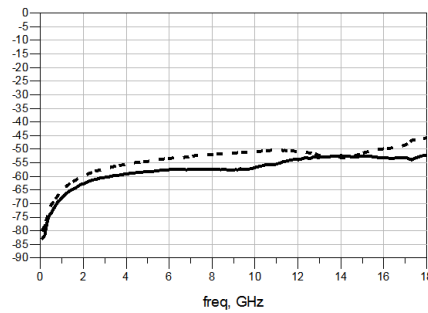
开态输出回波损耗



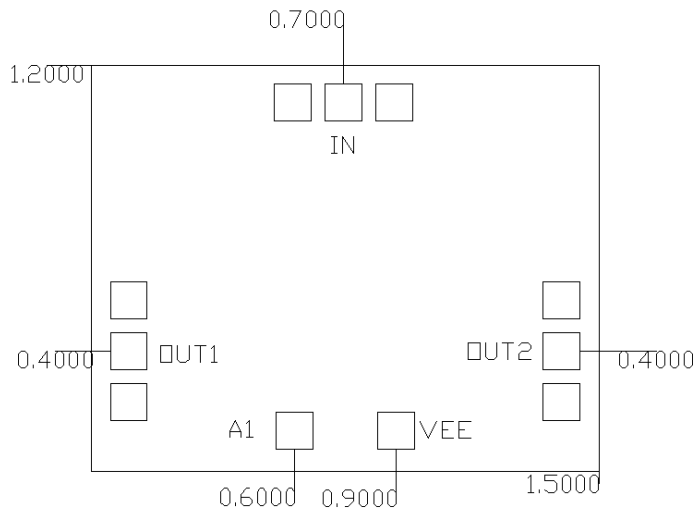
关态输出回波损耗



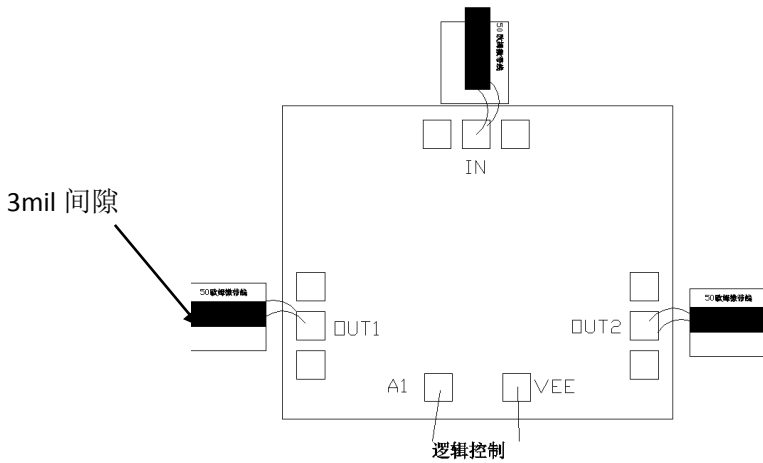
隔离度



尺寸图：(单位 mm)



**建议装配图：**



**使用说明：**

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 1 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度 300um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）

开  
关